

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
5 octobre 2017 (05.10.2017)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale

WO 2017/167573 A1

(51) Classification internationale des brevets :  
G01N 21/95 (2006.01)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/EP2017/055967

(22) Date de dépôt international :  
14 mars 2017 (14.03.2017)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
1652835 31 mars 2016 (31.03.2016) FR

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Déposant : UNITY SEMICONDUCTOR [FR/FR]; 611 rue Aristide Bergès, 38330 Montbonnot-Saint-Martin (FR).

(72) Inventeurs : GASTALDO, Philippe; 412, jardin de Bérénice, 38530 Pontcharra (FR). DURAND DE GEVIGNEY, Mayeul; 164 rue Dacquin, 73000 Chambéry (FR). COMBIER, Tristan; 61 rue Saint Laurent, 38000 Grenoble (FR).

(74) Mandataire : PONTET ALLANO & ASSOCIES; Parc Les Algorithmes, Bâtiment PLATON, CS 70003 Saint-Aubin, 91192 Gif Sur Yvette cedex (FR).

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

— relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet (règle 4.17.ii))

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METHOD AND SYSTEM FOR INSPECTING BOARDS FOR MICROELECTRONICS OR OPTICS BY LASER DOPPLER EFFECT

(54) Titre : PROCEDE ET SYSTEME D'INSPECTION PAR EFFET DOPPLER LASER DE PLAQUETTES POUR LA MICROELECTRONIQUE OU L'OPTIQUE

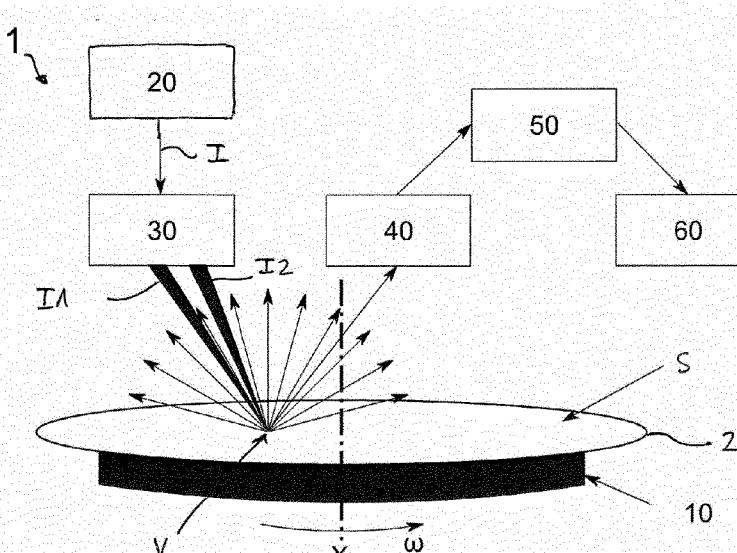


FIGURE 2

(57) Abstract : The invention relates to a method for inspecting a board (2) for electronics, optics or optoelectronics, which comprises: rotating the board (2) about an axis of symmetry (X) perpendicular to a main surface (S) of said board; emitting, from a light source (20) coupled with an interferometric device (30), two incident light beams so as to form, at the intersection between the two beams, a measurement space (V) containing interference fringes; collecting at least one portion of the light diffused by said region of the board; acquiring the collected light and emitting an electric signal representing the variation of the light intensity of the light collected over time; and detecting, in said signal, a frequency component in said collected light, said frequency being the time signature of the occurrence of a fault in the measurement space.

(57) Abrégé : L'invention concerne  
[Suite sur la page suivante]



— relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure (règle 4.17.iii))

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

---

un procédé d'inspection d'une plaquette (2) pour l'électronique, l'optique ou l'optoélectronique, comprenant : la mise en rotation de la plaquette (2) autour d'un axe de symétrie (X) perpendiculaire à une surface principale (S) de ladite plaquette, l'émission, à partir d'une source lumineuse (20) couplée à un dispositif interférométrique (30), de deux faisceaux lumineux incidents de sorte à former, à l'intersection entre les deux faisceaux, un volume de mesure (V) contenant des franges d'interférences, la collecte d'au moins une partie de la lumière diffusée par ladite région de la plaquette, l'acquisition de la lumière collectée et l'émission d'un signal électrique représentant la variation de l'intensité lumineuse de la lumière collectée en fonction du temps, la détection, dans ledit signal, d'une composante fréquentielle dans ladite lumière collectée, ladite fréquence étant la signature temporelle du passage d'un défaut dans le volume de mesure.

## PROCEDE ET SYSTEME D'INSPECTION PAR EFFET DOPPLER LASER DE PLAQUETTES POUR LA MICROELECTRONIQUE OU L'OPTIQUE

### DOMAINE DE L'INVENTION

5 La présente invention concerne un procédé et un système d'inspection par effet Doppler laser de plaquettes pour la microélectronique ou l'optique.

### ARRIERE PLAN DE L'INVENTION

10 Lors de la fabrication et l'utilisation de plaquettes (ou « wafers » selon la terminologie anglo-saxonne) pour la microélectronique ou l'optique, il est habituel de réaliser une inspection de la surface de chaque plaquette afin d'y détecter d'éventuels défauts et de déceler la ou les étapes générant ces défauts.

15 Par ailleurs, l'inspection ne vise généralement pas uniquement à déceler la présence ou non de défauts, mais aussi à fournir des informations qualitatives et/ou quantitatives sur lesdits défauts, telles que leur localisation, leur taille et/ou leur nature, par exemple.

Pour ces impératifs de sensibilité et surtout de répétabilité et de stabilité de mesure, une inspection visuelle par un opérateur n'est pas suffisante.

Des systèmes d'inspection ont donc été développés en vue de détecter des défauts 20 de plus en plus petits et de fournir toutes informations requises sur la nature, la taille, la localisation, etc. desdits défauts.

Ces systèmes doivent en outre permettre une durée d'inspection de chaque plaquette qui soit suffisamment courte pour ne pas pénaliser les cadences de fabrication.

25 A cet effet, une technique connue d'inspection de plaquettes est la microscopie en champ sombre (« dark field » selon la terminologie anglo-saxonne), qui consiste à émettre à partir d'une source lumineuse un faisceau en direction de la plaquette et à mesurer l'intensité de la lumière diffusée par la surface et ce qui est présent sur cette dernière. Une variation de l'intensité diffusée révèle donc la présence d'un défaut à la surface de la plaquette.

30 Le document WO 02/39099 décrit un système dark field d'inspection de plaquettes semi-conductrices reposant sur la vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV, acronyme du terme anglo-saxon « Laser Doppler Velocimetry »).

35 Comme on peut le voir sur la figure 1, un tel système 1 comprend une source lumineuse 20 et un dispositif interférométrique 30 couplé à la source lumineuse agencé en regard de la surface S de la plaquette 2 à inspecter, qui est animée d'un mouvement de rotation. Afin de former le dispositif interférométrique, un dispositif est utilisé pour diviser le faisceau l'issu de la source lumineuse 20 en deux faisceaux incidents I1, I2. A la sortie de ce diviseur, les deux faisceaux I1, I2 sont orientés l'un par rapport à l'autre de

sorte à former, à leur intersection, un volume de mesure V comprenant une pluralité de franges d'interférence parallèles. Le système 1 est conçu pour que la surface S de la plaquette passe dans ledit volume de mesure lors de son mouvement. La lumière diffusée à la surface de la plaquette est collectée par des miroirs et dirigée vers un dispositif 5 d'acquisition couplé à un module de détection (non représenté).

La présence d'un défaut sur la surface de la plaquette se traduit, lorsque ce défaut traverse les franges d'interférences, par la diffusion d'une bouffée Doppler mesurée par le module de détection. Une bouffée Doppler est un signal présentant une double composante fréquentielle : une composante de fréquence basse, formant l'enveloppe du 10 signal, correspondant à l'intensité lumineuse moyenne diffusée par le défaut, et une composante de fréquence haute, correspondant à la fréquence Doppler contenant l'information sur la vitesse du défaut. La fréquence Doppler  $f_D$  est liée à la vitesse  $v$  de déplacement du défaut dans la direction perpendiculaire aux franges et à la distance  $\Delta$  entre les franges d'interférences (ou distance interfranges) par la relation :  $v = f_D * \Delta$ .

15 Le document WO 2009/112704 décrit un autre système d'inspection de plaquettes basé sur la vélocimétrie laser à effet Doppler.

Dans le cas du document WO 02/39099, le volume de mesure produit, sur la surface de la plaquette, une tache elliptique dont le grand axe est orienté dans la direction radiale de la plaquette, les franges d'interférence s'étendant transversalement à la trajectoire de 20 rotation de la plaquette. La largeur de la tache elliptique est choisie suffisamment faible (40  $\mu\text{m}$ ) pour permettre de détecter précisément la position angulaire du défaut par rapport à un point de référence de la plaque. La longueur de la tache elliptique est choisie suffisamment grande (2 mm) pour permettre de réduire la durée d'inspection. Par ailleurs, la vitesse d'un défaut étant fonction de sa position radiale, il est possible, en mesurant la 25 fréquence Doppler de ce défaut, de déterminer la position radiale dudit défaut avec une précision plus grande que la taille de la tache.

Toutefois, malgré l'exploitation de la fréquence Doppler, un tel système présente une sensibilité insuffisante pour détecter de très petits défauts (typiquement, de l'ordre de 100 nm ou moins). En outre, ce système ne présente pas une résolution radiale 30 suffisante.

## BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

Un but de l'invention est de résoudre les problèmes précités et de concevoir un 35 système et un procédé d'inspection de plaquettes qui offre une sensibilité et une résolution radiale supérieures à celles des techniques connues. Notamment, des défauts de taille inférieure à 100 nm doivent pouvoir être détectés. Par ailleurs, ledit procédé doit

convenir à la fois aux plaquettes opaques et aux plaquettes au moins partiellement transparentes à la longueur d'onde de la source lumineuse employée.

Conformément à l'invention, il est proposé un procédé d'inspection d'une plaquette pour la microélectronique ou l'optique, comprenant :

5 - la mise en rotation de la plaquette autour d'un axe de symétrie perpendiculaire à une surface principale de ladite plaquette,

- l'émission, à partir d'une source lumineuse couplée à un dispositif interférométrique, de deux faisceaux lumineux incidents de sorte à former, à l'intersection entre les deux faisceaux, un volume de mesure contenant des franges d'interférences  
10 agencées de telle sorte qu'une région de la surface principale de la plaquette traverse au moins une frange du volume de mesure, la dimension dudit volume de mesure dans une direction radiale de la plaquette étant comprise entre 5 et 100 µm,

- la collecte d'au moins une partie de la lumière diffusée par ladite région de la plaquette,

15 - l'acquisition de la lumière collectée et l'émission d'un signal électrique représentant la variation de l'intensité lumineuse de la lumière collectée en fonction du temps,

- la détection, dans ledit signal, d'une composante fréquentielle dans ladite lumière collectée, ladite fréquence étant la signature temporelle du passage d'un défaut dans le volume de mesure.

20 Selon un mode de réalisation, la dimension du volume de mesure dans une direction tangentielle à la trajectoire de rotation de la plaquette est comprise entre 5 et 100 µm, de préférence entre 15 et 50 µm.

Selon une forme d'exécution de l'invention, la plaquette est au moins partiellement transparente à la longueur d'onde de la source lumineuse.

25 La dimension du volume de mesure dans une direction perpendiculaire à la surface de la plaquette est alors avantageusement inférieure ou égale au quart de l'épaisseur de ladite plaquette.

De manière particulièrement avantageuse, à l'emplacement du volume de mesure, les faisceaux incidents présentent une largeur minimale.

30 Selon un mode de réalisation, la puissance de la source lumineuse est supérieure ou égale à 10 mW.

La longueur d'onde de la source lumineuse est de préférence inférieure ou égale à 900 nm.

Selon un mode de réalisation, l'interfrange est compris entre 0,1 et 10 µm.

35 Un autre objet concerne un système d'inspection de plaquettes pour la microélectronique ou l'optique, comprenant :

- un dispositif d'entraînement d'une plaquette en rotation autour d'un axe de symétrie perpendiculaire à une surface principale de ladite plaquette,

- une source lumineuse adaptée pour émettre un faisceau lumineux,
- un dispositif interférométrique couplé à la source lumineuse pour diviser le faisceau émis par ladite source en deux faisceaux et pour former, à l'intersection entre les 5 deux faisceaux, un volume de mesure contenant des franges d'interférences, la dimension dudit volume de mesure dans une direction radiale de la plaquette étant comprise entre 5 et 100 µm, le dispositif interférométrique et le dispositif d'entraînement étant agencés l'un par rapport à l'autre de sorte qu'une région de la surface principale de la plaquette en rotation traverse au moins une frange du volume de mesure,
- 10 - un dispositif de collecte de la lumière diffusée par la plaquette,
- un dispositif d'acquisition de la lumière collectée configuré pour émettre un signal électrique représentant la variation de l'intensité lumineuse de la lumière collectée en fonction du temps,
- un dispositif de traitement configuré pour détecter, dans ledit signal, une 15 composante fréquentielle dans ladite lumière collectée, ladite fréquence étant la signature temporelle du passage d'un défaut dans un volume de mesure respectif et pour déterminer, à partir de ladite fréquence, la position du défaut dans la direction radiale et/ou dans l'épaisseur de la plaquette.

Selon un mode de réalisation, le système comprend en outre un bras pour déplacer 20 le dispositif interférométrique et le dispositif de collecte de la lumière diffusée en translation dans une direction radiale, la source lumineuse, le dispositif d'acquisition et le dispositif de traitement étant immobiles.

De manière avantageuse, ledit dispositif interférométrique est couplé à la source lumineuse par une fibre optique et ledit dispositif de collecte est couplé au dispositif 25 d'acquisition par une fibre optique.

#### **BREVE DESCRIPTION DES DESSINS**

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- 30 - la figure 1 est un schéma de principe d'un système d'inspection basé sur la vélocimétrie laser à effet Doppler, décrit dans le document WO 02/39099,
- la figure 2 est un schéma de principe d'un système d'inspection selon un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 3 est un schéma de principe d'un système optique de génération et de 35 collection de franges d'interférence selon un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 4 est un schéma de principe du volume de mesure comprenant des franges d'interférence selon un mode de réalisation de l'invention,

- la figure 5 est un schéma de principe d'un système d'inspection comprenant deux canaux de collecte de lumière,

- la figure 6 est un graphe représentant la résolution radiale en fonction de la position radiale du volume de mesure dans le cas du volume de mesure décrit dans le 5 document WO 02/39099.

Pour faciliter la lecture des figures, celles-ci ne sont pas nécessairement réalisées à l'échelle.

## DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

10 On s'intéresse dans la présente invention à toute plaquette destinée à être utilisée dans le domaine de la microélectronique ou de l'optique, ladite plaquette pouvant être opaque ou au moins partiellement transparente à la longueur d'onde d'un faisceau émis par une source lumineuse. En particulier, la plaquette peut comprendre au moins l'un des matériaux suivants : silicium, germanium, verre, saphir, quartz, SiC, AsGa, GaN (liste non 15 limitative).

L'invention utilise un volume de mesure de très petite dimension dans la direction radiale, voire également dans la direction tangentielle à la rotation de la plaquette.

20 Bien que cette solution aille à l'encontre de l'enseignement du document WO 02/39099, les inventeurs ont démontré, comme cela sera exposé plus bas, que ce volume de mesure sensiblement plus petit permettait d'obtenir un flux lumineux beaucoup plus élevé et, par conséquent, à puissance de fond lumineux égale, un rapport signal sur fond lumineux beaucoup plus favorable, sans pénaliser la durée d'inspection de la plaquette.

Le principe du système d'inspection 1 est illustré sur la figure 2.

25 Le système comprend un support 10 destiné à recevoir une plaquette 2 à inspecter et à l'entraîner en rotation autour d'un axe de symétrie X de la plaquette perpendiculaire à une surface principale S de ladite plaquette. En général, la plaquette est de forme circulaire mais l'invention peut s'appliquer à toute autre forme.

La plaquette 2 est maintenue sur le support 10 par tout moyen approprié, tel que des moyens électrostatiques, des moyens mécaniques, etc.

30 Le mécanisme de mise en rotation du support est connu en lui-même et ne sera donc pas décrit de manière détaillée.

Le support 10 comprend un ou plusieurs encodeurs (non illustrés) permettant de connaître à chaque instant la position angulaire de la plaquette par rapport à une position de référence.

35 Le système d'inspection 1 comprend en outre une source lumineuse 20.

La source lumineuse 20 est typiquement un laser de type DFB (acronyme du terme anglo-saxon « Distributed Feed Back »). Un laser de type Fabry-Pérot ayant une longueur de cohérence inférieure à 50µm peut dans certains cas être utilisé si la longueur des

chemins optiques des deux faisceaux divisés pour former le volume de mesure est inférieure à cette longueur de cohérence.

La puissance de ladite source lumineuse est typiquement supérieure ou égale à 10 mW. En effet, en-dessous de cette puissance, la quantité de lumière diffusée par des 5 défauts de taille inférieure à 100nm devient très faible et nécessite donc une durée d'acquisition incompatible avec l'application industrielle visée. Par ailleurs, la longueur d'onde de ladite source lumineuse est inférieure ou égale à 900nm. En effet, selon la loi de la diffusion de Mie, la puissance diffusée par un défaut de taille donnée augmente avec l'inverse de la puissance quatre de la longueur d'onde. Ainsi plus la longueur d'onde 10 incidente sur un défaut sera faible, plus celui-ci diffusera de lumière. Utiliser une longueur d'onde supérieure à 900nm engendrera donc des quantités de lumière diffusées trop faibles pour détecter des défauts de taille inférieure à 100nm.

La source lumineuse est couplée à un dispositif interférométrique 30 permettant de 15 générer un volume de mesure comprenant des franges d'interférence représenté sur la figure 3.

Le dispositif interférométrique 30 comprend un guide de lumière présentant deux branches symétriques dont l'entrée est couplée à la source lumineuse 20 pour diviser le faisceau I issu de la source lumineuse 20 en deux faisceaux incidents I1, I2. De préférence, le faisceau laser issu de la source lumineuse est collimaté. Une lentille 20 convergente L1, par exemple convexe-plane, est placée sur le trajet des deux faisceaux incidents de sorte à dévier chacun des deux faisceaux d'un angle  $\alpha$  pour former, à l'intersection entre les deux faisceaux, un volume de mesure V contenant des franges d'interférences. Naturellement, cette construction est donnée à titre d'exemple et tout autre dispositif permettant de former un tel volume de mesure peut être employé.

25 L'interfrange (distance entre deux franges adjacentes) est avantageusement compris entre 0,1 et 10  $\mu\text{m}$ . En effet, un interfrange inférieur à 0,1  $\mu\text{m}$  nécessiterait une fréquence d'échantillonnage plus élevée ce qui augmenterait considérablement la durée d'acquisition ou la rapidité de la chaîne d'acquisition nécessaire. Inversement, un interfrange supérieur à 10  $\mu\text{m}$  impliquerait un trop petit nombre de franges au sein du 30 volume de mesure pour faire une détection fréquentielle efficace. De plus, les défauts que la présente invention vise à qualifier étant de taille comprise entre 0,05 et 10  $\mu\text{m}$ , la plage d'interfrange susmentionnée permet de discriminer efficacement des défauts dans cette gamme de tailles.

Le volume de mesure généré par un tel dispositif interférométrique est illustré 35 schématiquement sur la figure 4.

Un repère orthonormé (x, y, z) est défini avec (x, y) dans le plan de la surface de la plaquette à inspecter et z perpendiculaire à ladite surface (la dimension du volume de mesure dans cette direction étant notée Dz). Dans cette illustration, on suppose que y

s'étend dans la direction radiale (la dimension du volume de mesure dans cette direction étant notée Dy et la dimension du volume de mesure dans la direction x orthogonale à y étant notée Dx).

Dans le cas d'une plaquette opaque à la longueur d'onde de la source lumineuse, la 5 dimension Dz ne revêt pas d'importance particulière, la surface à inspecter devant simplement passer à l'intérieur du volume de mesure.

Dans le cas d'une plaquette au moins partiellement transparente à la longueur d'onde de la source lumineuse, il est préférable de réduire autant que possible la dimension Dz afin d'avoir une résolution suffisante sur la position des éventuels défauts 10 détectés par rapport à l'épaisseur de la plaquette. D'une manière générale, on fait en sorte que la dimension Dz soit inférieure au quart de l'épaisseur de la plaquette à inspecter. En effet, au-delà de ce ratio, de gros défauts sur la face arrière d'une plaquette transparente peuvent laisser une forte signature qui engendre des fausses détections.

Les dimensions Dx et Dy sont chacune choisies entre 5 et 100 µm, de préférence 15 entre 15 et 50 µm. La borne inférieure égale à 5 µm est liée au fait qu'en-dessous de cette dimension, la durée d'inspection serait excessivement longue pour un procédé mis en œuvre industriellement. La borne supérieure de 100 µm est définie pour garder un flux le plus grand possible, permettre une localisation précise des défauts à la surface de la plaquette et enfin pour diminuer la probabilité de considérer comme un seul défaut deux 20 défauts qui viendraient à passer dans le volume de mesure simultanément.

A titre purement indicatif, le volume de mesure peut présenter des dimensions de 50\*50µm dans le plan (x, y), ou encore de 20\*20µm. Les dimensions du volume de mesure ne sont pas nécessairement égales dans les directions x et y.

Pour obtenir un volume de mesure aussi petit que dans la présente invention, il est 25 généralement nécessaire que la largeur des faisceaux au niveau du volume de mesure corresponde au double du rayon minimal desdits faisceaux (« waist » selon la terminologie anglo-saxonne, notée usuellement  $W_0$ ).

Avec D le diamètre de ces faisceaux, F la focale de la lentille L1 et  $\lambda$  la longueur d'onde de la source lumineuse, l'optique gaussienne permet d'obtenir la relation suivante :

$$2 * W_0 = \frac{4 \cdot F \cdot \lambda}{\pi \cdot D}$$

30 On peut ainsi définir la valeur de waist convenable en choisissant avantageusement la largeur des faisceaux en entrée, leur espacement et la focale de la lentille de sortie.

Par ailleurs, alors que le système décrit dans le document WO 02/39099 ne concerne que des plaquettes opaques à la longueur d'onde du faisceau, la présente invention permet d'inspecter également des substrats transparents. Dans ce cas, on 35 cherche en outre à faire une détection qui soit la plus restreinte selon l'épaisseur du substrat, direction appelée ci-après Z ou profondeur de champ.

On suppose un volume de mesure créé par deux faisceaux issus de la même source, qui ont un waist de taille  $W_0$ , et qui sont incidents avec un demi-angle  $\alpha$ .

Sauf indication contraires, les dimensions  $W_0, D_y, D_x, D_z$  sont exprimées en largeur à  $1/e^2$  de la puissance maximale.

5 On obtient les relations suivantes :

$$D_x = 2 * W_0$$

$$D_y = \frac{2 * W_0}{\cos(\alpha)}$$

$$D_z = \frac{2 * W_0}{\sin(\alpha)}$$

$$\frac{D_x}{D_z} = \tan(\alpha)$$

Dans le cas d'un substrat transparent, d'une épaisseur de 300 µm, on cherche à avoir par exemple une profondeur de champ  $D_z$  de l'ordre de 50 µm, avec des dimensions  $D_x$  et  $D_y$  de l'ordre de 20 µm. On recherche donc un rapport  $D_x/D_z = 0,4$  soit un angle  $\alpha$  de 21°.

10 Dans le cas où l'on recherche une détection sensible sur substrat transparent, on cherche à réduire autant que possible  $W_0$  pour augmenter le flux incident : cela se fait en augmentant le diamètre du laser en amont de la lentille L1.

La diminution de  $D_z$  peut être obtenue en augmentant  $\alpha$ .

15 L'invention permet donc de déterminer les paramètres pour créer un volume de mesure optimal pour la détection de petits défauts sur un substrat, y compris transparent, en faisant varier uniquement trois paramètres : la taille des faisceaux en entrée, la séparation de ces faisceaux en amont de la lentille L1 et la focale de cette lentille L1.

20 Revenant à la figure 2, le système d'inspection comprend par ailleurs un dispositif 40 de collecte de la lumière diffusée par la région de la plaquette traversant le volume de mesure.

Selon un mode de réalisation, ce dispositif 40 peut comprendre une fibre optique de préférence de grand diamètre de cœur (c'est-à-dire typiquement entre 50 et 2000 µm de diamètre), dont l'entrée est agencée à la focale d'un miroir ellipsoïdal ou d'une lentille d'un système de collection composé de lentilles et dont la sortie est couplée à un dispositif 50 d'acquisition de la lumière collectée pour émettre un signal électrique représentant la variation de l'intensité lumineuse de la lumière collectée en fonction du temps. Ledit dispositif 50 comprend typiquement un photodétecteur.

Selon un mode de réalisation avantageux, le dispositif 40 peut être inclus dans le dispositif 30 de génération du volume de mesure.

30 Ainsi, comme illustré sur la figure 3, la lentille L1 permettant de former le volume de mesure est également utilisée pour collecter la lumière diffusée par les défauts traversant le volume de mesure (chemin optique représenté par des hachures). Une seconde lentille

L2 agencée en aval de la lentille L1 sur le trajet de la lumière collectée, entre les faisceaux incidents, permet de diriger la lumière collectée vers une fibre optique ou un dispositif d'acquisition (non représenté sur la figure 3). L'angle solide de collection  $\beta$  est alors généralement limité par l'angle des faisceaux incidents.

5 Plus l'angle  $\alpha$  est grand, plus l'angle solide  $\beta$  est grand et la quantité de lumière collectée est importante.

D'une manière générale, on choisit un angle solide supérieur à 0,1% de la demi-sphère (ou 0,0062 stéradians). En effet, en-dessous de cette valeur, la quantité de lumière collectée devient très faible et nécessite une durée d'acquisition incompatible 10 avec une mise en œuvre industrielle du procédé d'inspection.

Selon une variante de réalisation, illustrée à la figure 5, il est avantageux de combiner le canal de collection C1 agencé entre les faisceaux incidents décrit plus haut avec un second canal de collection C2 utilisant un miroir de collection M agencé de sorte à collecter la lumière présentant un angle de diffusion élevé par rapport à la normale à la 15 surface S de la plaquette inspectée.. Cette mise en œuvre permet d'une part de collecter plus de lumière, et d'autre part d'obtenir plus d'information sur les différents défauts, chaque canal permettant d'obtenir des informations différentes selon les défauts.

Enfin, le système d'inspection 1 comprend un dispositif 60 de traitement (cf. figure 2) configuré pour détecter, dans ledit signal, une composante fréquentielle correspondant 20 à la fréquence Doppler.

Le dispositif de traitement 60 est avantageusement couplé à une interface (non illustrée) permettant à un utilisateur d'accéder aux résultats de l'inspection afin notamment de les visualiser, de les enregistrer et/ou de les imprimer.

Pour inspecter une plaquette, on met en place ladite plaquette 2 sur le support 10 et 25 l'on entraîne le support en rotation à une vitesse angulaire  $\omega$  contrôlée. Grâce aux encodeurs présents sur le support 10, on connaît à chaque instant la position angulaire d'un point donné de la plaquette. La vitesse de rotation de la plaquette est typiquement de l'ordre de 5000 tours/min.

Dans le système d'inspection 1, le dispositif interférométrique 30 et le dispositif de 30 collecte 40 sont agencés en regard d'une surface principale de la plaquette 2, sur un bras (non illustré) adapté pour déplacer lesdits dispositifs 30, 40 dans une direction radiale. En revanche, la source lumineuse 20 ainsi que les dispositifs d'acquisition et de traitement 50, 60 sont déportés et reliés aux dispositifs 30, 40 par des fibres optiques (non représentées). La partie mobile du système d'inspection présente donc un poids et un 35 encombrement limités qui facilitent son déplacement, tandis que la source lumineuse, et les dispositifs d'acquisition et de traitement, qui sont encombrants, lourds et difficilement embarquables, restent immobiles. Cela permet également de réduire les longueurs de câbles de transport du signal électrique, ce qui réduit la sensibilité aux bruits

électroniques environnantes. Ainsi, compte tenu de la rotation de la plaquette, on peut balayer successivement l'ensemble de la surface de la plaquette avec le volume de mesure en translatant radialement le dispositif interférométrique ainsi que le dispositif de collecte de la lumière diffusée.

5 On fait en sorte que les franges d'interférences s'étendent transversalement à la trajectoire de rotation de la plaquette, de sorte qu'un point de la surface de la plaquette traverse au moins une frange, de préférence plusieurs franges du volume de mesure. Dans le présent texte, le terme « transversalement » signifie donc que les franges sont perpendiculaires ou inclinées d'un angle non nul par rapport à cette trajectoire.

10 Résultats comparatifs

Augmentation de la sensibilité

Le présent paragraphe présente les résultats en termes de sensibilité pour un volume de mesure de 40 µm par 2 mm (noté ci-après VM1) comme dans le document WO 02/39099 et pour un volume de mesure de 40 µm par 40 µm (noté ci-après VM2), 15 correspondant à un mode de réalisation de la présente invention. La dimension du volume de mesure dans la direction perpendiculaire à la surface de la plaquette n'a pas d'importance dans le présent exemple.

Les conditions d'acquisition (communes aux deux configurations du volume de mesure) sont les suivantes.

20 La source lumineuse est un laser présentant une longueur d'onde de 488 nm et une puissance de 100 mW.

La plaquette est un substrat de silicium de 100 mm de diamètre.

L'isolation dark field (rapport du fond lumineux sur la puissance d'entrée, le fond lumineux correspondant à de la pollution lumineuse collectée) est de 90 dB.

25 La durée d'acquisition est de 60 s.

Le nombre de points de mesure par tour est de 1000 (résolution tangentielle).

Le défaut à détecter présente un diamètre de 100 nm, ce qui correspond à une section efficace totale, à 488 nm, de  $3,5 \times 10^{-16}$  m<sup>2</sup> selon la théorie de Mie, utilisant une particule sphérique d'indice 1,58 dans l'air. Ce modèle donne un bon ordre de grandeur, 30 en accord avec les mesures effectuées par les inventeurs.

La mesure choisie pour caractériser la sensibilité d'un système dark field est le rapport entre l'énergie lumineuse de signal et l'énergie lumineuse de fond.

Pour les calculs suivants, on fait l'hypothèse que la puissance de fond lumineux est uniquement liée à la qualité de la chaîne optique de collection et qu'elle est 35 proportionnelle à la puissance lumineuse d'entrée.

Lors de la détection d'un défaut, le rapport signal sur bruit photonique (SNR-ph) - lié à la statistique de détection - est proportionnel au rapport signal/ $\sqrt{\text{fond}}$ , qui dépend donc

de la puissance lumineuse d'entrée. On s'intéresse dans la suite de l'exposé au rapport signal/fond, car c'est un indicateur indépendant de la puissance lumineuse d'entrée.

On calcule le rapport signal sur fond lumineux d'un défaut de 100 nm passant dans chacun des deux volumes de mesures VM1, VM2.

- 5 La géométrie de ces deux volumes de mesure, ainsi que les paramètres communs d'acquisition décrits plus haut implique un ensemble de valeurs de puissance et d'énergie par point de mesure qui sont résumés ci-dessous :

	Paramètres déduits			
	Flux [W/m <sup>2</sup> ]	Nombre de tours	Durée d'un tour [s]	Durée d'un point d'acquisition [s]
VM1	1250000	25	2.4	0.0024
VM2	62500000	1250	0.048	0.000048

	Paramètres énergétiques déduits			
	Puissance de signal [W]	Energie de signal [J]	Energie de fond lumineux [J]	Rapport Signal sur Fond lumineux
VM1	4.4E-10	1.05E-12	2.40E-13	4.4
VM2	2.2E-08	1.05E-12	4.80E-15	219

10

On remarque dans ces calculs que l'énergie de signal est égale dans les deux cas, ce qui provient du fait que les deux phénomènes (passage de longue durée dans un volume de mesure (VM1) au flux lumineux faible / passage de courte durée dans un volume de mesure (VM2) au flux lumineux élevé) se compensent.

15

L'avantage de la présente invention est centré sur l'énergie de fond lumineux collectée dans les deux cas. La puissance de fond lumineux dépend uniquement de la puissance envoyée et de la collection utilisée, qui sont les mêmes dans les deux cas. Cependant, le volume de mesure VM1 intègre à chaque point de mesure beaucoup plus de photons de fond lumineux que le volume de mesure VM2, d'où un rapport signal sur fond lumineux bien plus avantageux dans le cas du volume de mesure VM2.

Un calcul simple permet de déduire que le gain en rapport signal/fond est inversement égal au rapport des aires de chacun des volumes de mesure. Dans le cas décrit ici,  $(Dx^*Dy)_{VM2}/(Dx^*Dy)_{VM1} = 1/50$ , ce qui correspond bien à l'inverse du gain de signal/fond.

25

Il est à noter que la réduction de taille du volume de mesure est également un grand avantage dans le cas de recherche de petites particules en présence de micro-rugosité du substrat qui génère une diffusion de la lumière (« Haze » dans sa dénomination anglo-saxonne). En effet, tout substrat présente une certaine micro-rugosité qui dépend de la 5 qualité de son polissage. Cette micro-rugosité est sensiblement homogène sur la surface et génère donc une diffusion sensiblement uniforme. En outre, contrairement aux éventuelles particules qui peuvent être présentes à la surface, toute la surface du substrat est impactée par cette micro-rugosité.

En général, cette diffusion (ou haze) est mesuré en parties par million de la 10 puissance lumineuse incidente sur le substrat (ou PPM).

La puissance de haze mesurée ne dépend pas de la surface du volume de mesure projeté sur le substrat mais uniquement de la puissance de la source lumineuse et de la rugosité du substrat. Ainsi, pour une puissance lumineuse de 100mW et une diffusion due à la micro-rugosité de 1PPM, la puissance de Haze reçue sera de :

$$P_{\text{haze}} = P_{\text{laser}} * \text{Haze}$$

$$P_{\text{haze}} = 0.1 * 1 * 10^{-7}$$

$$P_{\text{haze}} = 10\text{nW}$$

15 Dans ce cas, on trouve dans les deux configurations VM1 et VM2 les résultats suivants :

	<u>Puissance de Haze</u> <u>[W]</u>	<u>Puissance de signal</u> <u>particule de 100nm [W]</u>	<u>Rapport</u> <u>Signal / Haze</u>
<u>VM1</u> <u>(WO 02/39099)</u>	<u>1E-8</u>	<u>4.4E-10</u>	<u>0.044</u>
<u>VM2 (présente</u> <u>invention)</u>	<u>1E-8</u>	<u>2.2E-8</u>	<u>2.2</u>

On remarque ainsi que dans le cas du volume de mesure VM1, la particule de 20 100nm est noyée dans le haze car sa puissance diffusée est plus de vingt fois plus faible que la puissance de haze, alors que dans le cas du volume de mesure VM2 de l'invention, la particule est bien visible dans le haze car sa puissance diffusée correspond à plus du double de la puissance du haze.

25 Ainsi, si on réduit l'aire du volume de mesure projeté sur la surface à inspecter d'un facteur N, le rapport Signal / Haze est augmenté de ce même facteur N.

Augmentation de la résolution radiale

La résolution d'un système dark field est en général déterminée par la taille du faisceau scannant la surface à inspecter.

5 Cependant, dans le document WO 02/39099, il est proposé un moyen d'avoir une meilleure résolution à l'aide de la variation de fréquence Doppler des défauts passant dans le volume de mesure. En effet, un défaut plus proche du centre de rotation du substrat a une vitesse linéaire plus faible qu'un défaut loin du centre de rotation du substrat. En mesurant cette fréquence Doppler, on pourrait ainsi situer avec plus de  
10 précision le défaut que la taille du faisceau.

Toutefois, même si cette théorie se vérifie, on démontre ci-après qu'en considérant les erreurs de mesure, ce gain de résolution reste très faible et ne permet en tout état de cause pas d'atteindre la résolution radiale obtenue avec la présente invention.

15 En effet, considérant un volume de mesure de taille  $40\mu\text{m}^*2\text{mm}$  avec son grand axe s'étendant de manière radiale comme décrit dans le document WO 02/39099, et un interfrange de  $1\mu\text{m}$ , on obtient alors un volume de mesure avec 40 franges.

On appelle  $l$  la largeur de la bouffée en microns,  $\delta$  l'interfrange,  $V_t$  la vitesse de passage du défaut dans le volume de mesure,  $R$  le rayon scanné,  $\omega$  la vitesse angulaire de rotation,  $f_d$  la fréquence Doppler du défaut détecté

20 L'incertitude avec laquelle on peut déterminer une fréquence est liée à la largeur du pic spectrale de ladite fréquence. Or, dans le cas d'une bouffée de durée  $\Delta t$ , la largeur spectrale du pic est environ de  $\Delta f = \frac{1}{\Delta t}$ .

On cherche donc à calculer  $\Delta f$  en fonction du nombre de frange :

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta t} = \frac{V_t}{l} = \frac{\delta \cdot f_d}{l}$$

25 On ne peut ainsi pas déterminer la fréquence Doppler  $f_d$  avec une meilleure précision que  $\Delta f = \frac{\delta \cdot f_d}{l}$ .

Il est connu que la fréquence Doppler dans un tel système est liée à la position radiale, à l'interfrange et à la vitesse angulaire de rotation par la relation suivante :

$$f_d = \frac{\omega \cdot R}{\delta}$$

Ainsi, on peut écrire la relation sur les incertitudes suivantes :

$$\Delta f_d = \frac{\omega}{\delta} \cdot \Delta R$$

Les valeurs  $\omega$  et  $R$  étant ici constantes.

30 On obtient donc pour une incertitude  $\Delta f_d$  donnée une incertitude sur la position radiale qui est

$$\Delta R = \frac{\delta}{\omega} \cdot \Delta f_d$$

Ainsi on peut conclure par :

$$\Delta R = \frac{\delta}{\omega} \cdot \frac{\delta}{l} f_d = \frac{\delta}{l} \cdot R$$

Cette relation permet ainsi de lier l'incertitude sur la position radiale déterminée à l'aide de la fréquence Doppler au rayon scanné, à l'interfrange et à la largeur du volume de mesure. Cette incertitude  $i$ , qui est dans ce cas égale à la résolution radiale, est tracée sur la figure 6 en fonction du rayon  $R$  pour les valeurs données précédemment.

5 On observe dans cet exemple que le volume de mesure présenté dans le document WO 02/39099 que la résolution radiale diminue très vite avec le rayon scanné, avant d'être finalement limitée par la taille du volume de mesure lui-même (plateau à partir de 80mm de rayon scanné). Par exemple, si on veut une résolution radiale de 50 $\mu\text{m}$ , on est limité à un rayon de scan de 2mm. Pour avoir une résolution radiale de 50 $\mu\text{m}$  sur une  
10 plaquette de 300mm de rayon avec un interfrange de 1 $\mu\text{m}$ , on doit alors avoir un volume de mesure de 333 $\mu\text{m}$  de large, ce qui réduit encore le flux lumineux (cf. considérations précédentes sur la sensibilité).

Au contraire, un des avantages de la présente invention est que la résolution radiale est définie à minima par la taille du volume de mesure. Pour compenser la plus petite  
15 taille du volume de mesure, le procédé selon l'invention nécessite une rotation plus rapide de la plaquette que dans le document WO 02/39099 pour conserver une même durée d'inspection. Toutefois, la vitesse nécessaire est aisément atteinte, des dispositifs de rotation rapide (« spindle » selon la terminologie anglo-saxonne) permettant de faire tourner des plaquettes jusqu'à 300mm de diamètre à des vitesses de plusieurs milliers de  
20 tours par minute. En outre, des photodétecteurs et des cartes d'acquisition de données fonctionnant à des fréquences compatibles avec ces vitesses et les fréquences Doppler qui en découlent sont également disponibles.

## REFERENCES

- 25 WO 2009/112704  
WO 02/39099

**REVENDICATIONS**

1. Procédé d'inspection d'une plaquette (2) pour l'électronique, l'optique ou l'optoélectronique, comprenant :

5 - la mise en rotation de la plaquette (2) autour d'un axe de symétrie (X) perpendiculaire à une surface principale (S) de ladite plaquette,

- l'émission, à partir d'une source lumineuse (20) couplée à un dispositif interférométrique (30), de deux faisceaux lumineux incidents de sorte à former, à l'intersection entre les deux faisceaux, un volume de mesure (V) contenant des franges 10 d'interférences agencées de telle sorte qu'une région de la surface principale (S) de la plaquette traverse au moins une frange du volume de mesure, la dimension (Dy) dudit volume de mesure dans une direction radiale de la plaquette étant comprise entre 5 et 100  $\mu\text{m}$ ,

15 - la collecte d'au moins une partie de la lumière diffusée par ladite région de la plaquette,

- l'acquisition de la lumière collectée et l'émission d'un signal électrique représentant la variation de l'intensité lumineuse de la lumière collectée en fonction du temps,

- la détection, dans ledit signal, d'une composante fréquentielle dans ladite lumière collectée, ladite fréquence étant la signature temporelle du passage d'un défaut dans le 20 volume de mesure.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la dimension (Dx) du volume de mesure dans une direction tangentielle à la trajectoire de rotation de la plaquette est comprise entre 5 et 100  $\mu\text{m}$ , de préférence entre 15 et 50  $\mu\text{m}$ .

25

3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel la plaquette est au moins partiellement transparente à la longueur d'onde de la source lumineuse.

30 4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel la dimension (Dz) du volume de mesure dans une direction perpendiculaire à la surface de la plaquette est inférieure ou égale au quart de l'épaisseur de ladite plaquette.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel, à l'emplacement du volume de mesure, les faisceaux incidents présentent une largeur minimale ( $2^*W_0$ ).

35

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la puissance de la source lumineuse est supérieure ou égale à 10 mW.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la longueur d'onde de la source lumineuse est inférieure ou égale à 900 nm.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel l'interfrange est 5 compris entre 0,1 et 10 µm.

9. Système (1) d'inspection de plaquettes (2) pour la microélectronique ou l'optique, comprenant :

- un dispositif (10) d'entraînement d'une plaquette en rotation autour d'un axe (X) de 10 symétrie perpendiculaire à une surface principale (S) de ladite plaquette,

- une source lumineuse (20) adaptée pour émettre un faisceau lumineux,

- un dispositif interférométrique (30) couplé à la source lumineuse pour diviser le faisceau émis par ladite source (20) en deux faisceaux et pour former, à l'intersection entre les deux faisceaux, un volume de mesure (V) contenant des franges d'interférences,

15 la dimension (Dy) dudit volume de mesure dans une direction radiale de la plaquette étant comprise entre 5 et 100 µm, le dispositif interférométrique (30) et le dispositif d'entraînement (10) étant agencés l'un par rapport à l'autre de sorte qu'une région de la surface principale de la plaquette en rotation traverse au moins une frange du volume de mesure,

20 - un dispositif (40) de collecte de la lumière diffusée par la plaquette,

- un dispositif (50) d'acquisition de la lumière collectée configuré pour émettre un signal électrique représentant la variation de l'intensité lumineuse de la lumière collectée en fonction du temps,

25 - un dispositif (60) de traitement configuré pour détecter, dans ledit signal, une composante fréquentielle dans ladite lumière collectée, ladite fréquence étant la signature temporelle du passage d'un défaut dans un volume de mesure respectif et pour déterminer, à partir de ladite fréquence, la position du défaut dans la direction radiale et/ou dans l'épaisseur de la plaquette.

30 10. Système selon la revendication 9, comprenant en outre un bras pour déplacer le dispositif interférométrique (30) et le dispositif (40) de collecte de la lumière diffusée en translation dans une direction radiale, la source lumineuse, le dispositif d'acquisition et le dispositif de traitement étant immobiles.

35 11. Système selon la revendication 10, dans lequel ledit dispositif interférométrique est couplé à la source lumineuse par une fibre optique et ledit dispositif de collecte est couplé au dispositif d'acquisition par une fibre optique.

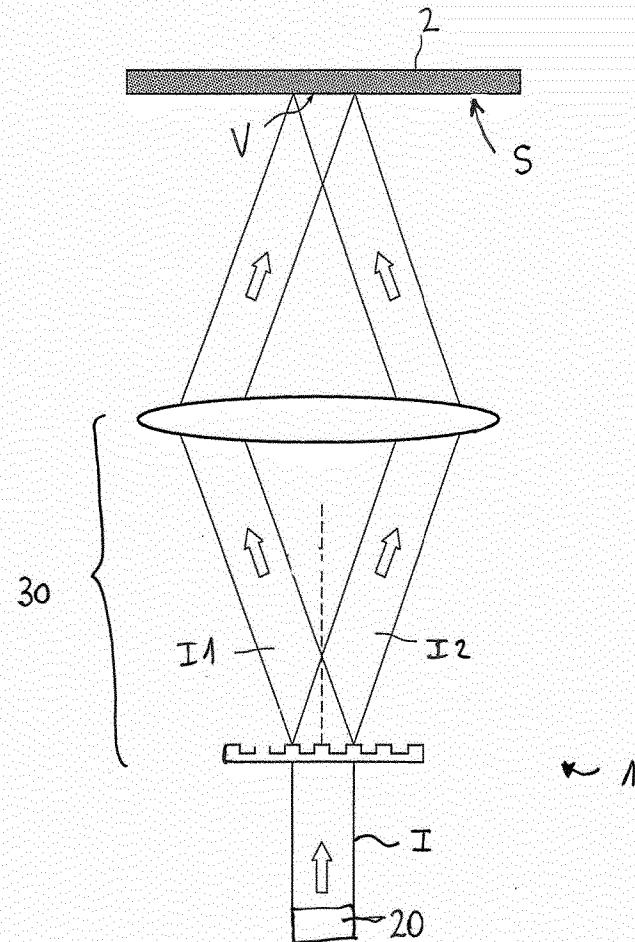


FIGURE 1

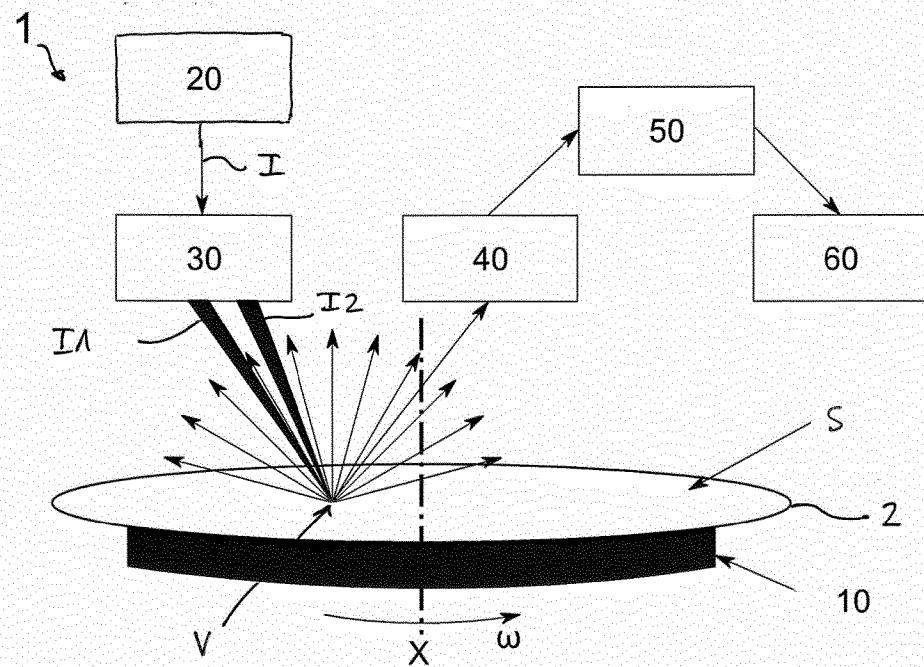


FIGURE 2

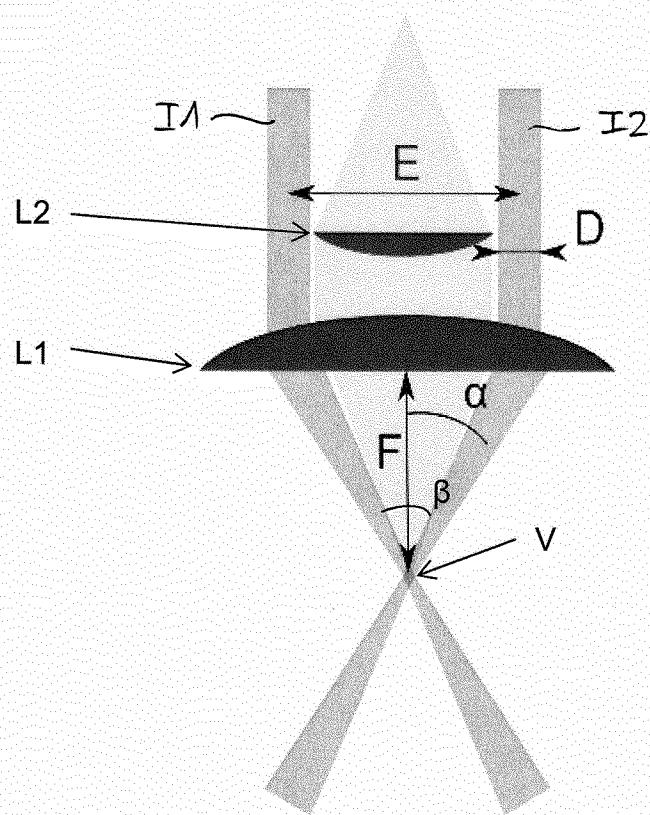


FIGURE 3

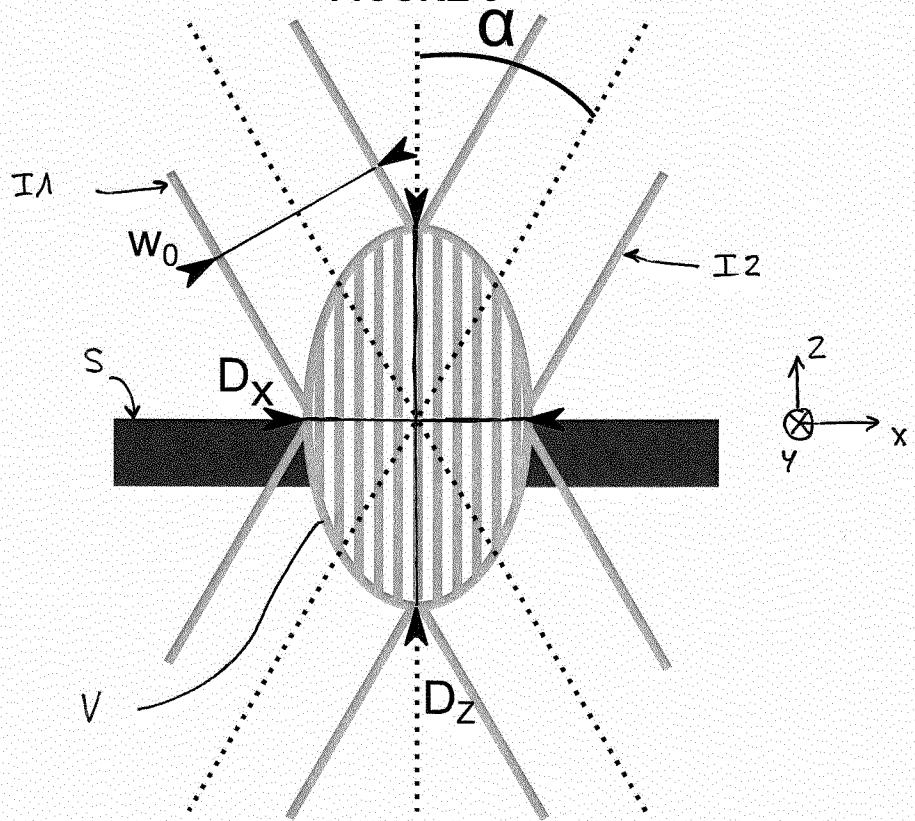
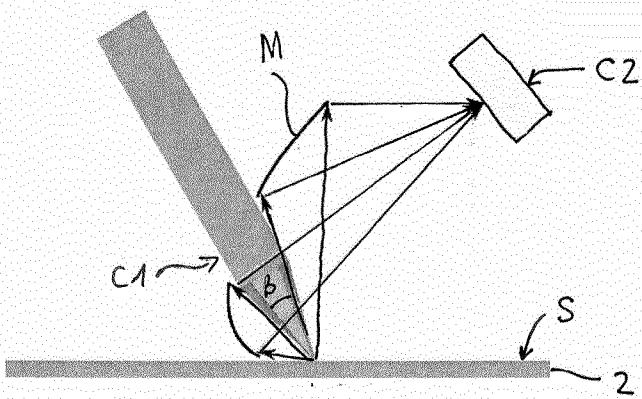
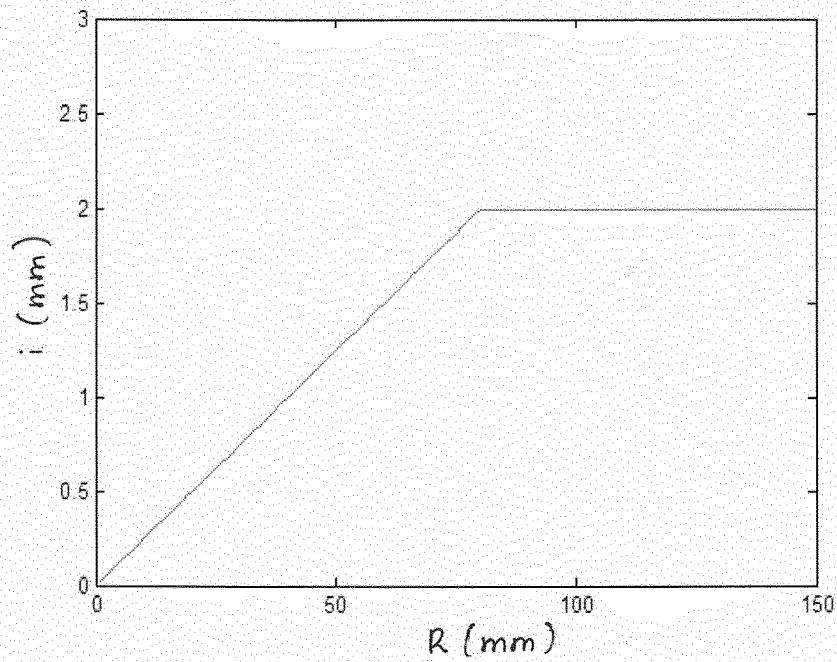


FIGURE 4

**FIGURE 5****FIGURE 6**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/EP2017/055967

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
INV. G01N21/95  
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/39099 A2 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]; TUKKER TEUNIS W [NL]; HOOFT GERT) 16 May 2002 (2002-05-16) cited in the application abstract; figures 1-3, 6, 9-11 page 3 - page 6 -----	1-11
X, P	WO 2016/050735 A1 (ALTATECH SEMICONDUCTOR [FR]) 7 April 2016 (2016-04-07) abstract; claim 1; figure 1 page 8, lines 30-31 page 12, lines 26-28 -----	1-11
X, P	WO 2016/050738 A1 (ALTATECH SEMICONDUCTOR [FR]) 7 April 2016 (2016-04-07) abstract; claim 1; figure 4b page 8, lines 30-31 page 15, lines 4-10 -----	1-11
	-/-	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date  
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
29 May 2017	07/06/2017
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3046	Authorized officer  Vorropoulos, G

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/EP2017/055967

## C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 710 629 A (KEVORKIAN ANTOINE [FR] ET AL) 20 January 1998 (1998-01-20) abstract; figures 1,2 column 2 column 3, lines 5-12 -----	1-11
A	US 5 343 290 A (BATCHELDER JOHN S [US] ET AL) 30 August 1994 (1994-08-30) abstract; figures 1,2 -----	1-11
A	US 5 883 714 A (JANN PETER C [US] ET AL) 16 March 1999 (1999-03-16) abstract; figures 1,5 -----	1-11

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No PCT/EP2017/055967
---

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
WO 0239099	A2	16-05-2002	EP 1336094 A2 JP 2004513364 A US 2002191179 A1 WO 0239099 A2		20-08-2003 30-04-2004 19-12-2002 16-05-2002
WO 2016050735	A1	07-04-2016	FR 3026485 A1 SG 11201701774S A WO 2016050735 A1		01-04-2016 27-04-2017 07-04-2016
WO 2016050738	A1	07-04-2016	FR 3026484 A1 SG 11201702300P A WO 2016050738 A1		01-04-2016 27-04-2017 07-04-2016
US 5710629	A	20-01-1998	DE 69314348 D1 DE 69314348 T2 EP 0673500 A1 ES 2110211 T3 FR 2699269 A1 JP 3317970 B2 JP H08504945 A US 5710629 A WO 9414028 A1		06-11-1997 19-03-1998 27-09-1995 01-02-1998 17-06-1994 26-08-2002 28-05-1996 20-01-1998 23-06-1994
US 5343290	A	30-08-1994	JP H0650903 A US 5343290 A		25-02-1994 30-08-1994
US 5883714	A	16-03-1999	NONE		

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2017/055967

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
INV. G01N21/95  
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
G01N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 02/39099 A2 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]; TUKKER TEUNIS W [NL]; HOOFT GERT) 16 mai 2002 (2002-05-16) cité dans la demande abrégé; figures 1-3, 6, 9-11 page 3 - page 6 -----	1-11
X, P	WO 2016/050735 A1 (ALTATECH SEMICONDUCTOR [FR]) 7 avril 2016 (2016-04-07) abrégé; revendication 1; figure 1 page 8, lignes 30-31 page 12, lignes 26-28 -----	1-11
X, P	WO 2016/050738 A1 (ALTATECH SEMICONDUCTOR [FR]) 7 avril 2016 (2016-04-07) abrégé; revendication 1; figure 4b page 8, lignes 30-31 page 15, lignes 4-10 -----	1-11
		-/-

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

29 mai 2017

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

07/06/2017

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Vorropoulos, G

**RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE**

Demande internationale n°

PCT/EP2017/055967

## C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 710 629 A (KEVORKIAN ANTOINE [FR] ET AL) 20 janvier 1998 (1998-01-20) abrégé; figures 1,2 colonne 2 colonne 3, lignes 5-12 -----	1-11
A	US 5 343 290 A (BATCHELDER JOHN S [US] ET AL) 30 août 1994 (1994-08-30) abrégé; figures 1,2 -----	1-11
A	US 5 883 714 A (JANN PETER C [US] ET AL) 16 mars 1999 (1999-03-16) abrégé; figures 1,5 -----	1-11
1		

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2017/055967

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)			Date de publication
WO 0239099	A2	16-05-2002	EP 1336094 A2 JP 2004513364 A US 2002191179 A1 WO 0239099 A2		20-08-2003 30-04-2004 19-12-2002 16-05-2002
WO 2016050735	A1	07-04-2016	FR 3026485 A1 SG 11201701774S A WO 2016050735 A1		01-04-2016 27-04-2017 07-04-2016
WO 2016050738	A1	07-04-2016	FR 3026484 A1 SG 11201702300P A WO 2016050738 A1		01-04-2016 27-04-2017 07-04-2016
US 5710629	A	20-01-1998	DE 69314348 D1 DE 69314348 T2 EP 0673500 A1 ES 2110211 T3 FR 2699269 A1 JP 3317970 B2 JP H08504945 A US 5710629 A WO 9414028 A1		06-11-1997 19-03-1998 27-09-1995 01-02-1998 17-06-1994 26-08-2002 28-05-1996 20-01-1998 23-06-1994
US 5343290	A	30-08-1994	JP H0650903 A US 5343290 A		25-02-1994 30-08-1994
US 5883714	A	16-03-1999	AUCUN		